



Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργαστήριο Συστημάτων VLSI και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών



EPFAXTHPIO HAEKTPONIKHX

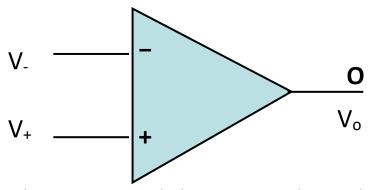
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΓΟΣ ΑΜ4835 2ο Ετος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

1.1 Τελεστικοί ενισχυτές

1.1.1 Εισαγωγή: Αντικείμενο της εργαστηριακής άσκησης είναι η επαφή με ένα από τα πιο χρήσιμα κυκλώματα, αυτό του *τελεστικού ενισχυτή* (operational amplifier – OpAmp). Σε αυτή την άσκηση ο φοιτητής θα εξοικειωθεί με τις έννοιες της ενίσχυσης σήματος, της αντιστροφής σήματος και θα γνωρίσει κάποια βασικά εργαλεία ανάλυσης κυκλωμάτων.

Ο τελεστικός ενισχυτής είναι ένας πολύ υψηλού κέρδους διαφορικός ενισχυτής στον οποίο χρησιμοποιούνται τεχνικές ανάδρασης για να επιτευχθεί ο έλεγχος της χαρακτηριστικής απόκρισής του. Το κυκλωματικό του σύμβολο δίδεται στο Σχήμα 1.1 που ακολουθεί.



Σχήμα 1.1: Κυκλωματικό σύμβολο τελεστικού ενισχυτή

Οι ακροδέκτες + και - αποτελούν εισόδους σήματος του ενισχυτή ενώ ο ακροδέκτης Ο είναι η έξοδος σήματος. Η τάση εξόδου ενός τελεστικού ενισχυτή είναι ίση με τη διαφορά των τάσεων οι οποίες εφαρμόζονται στους ακροδέκτες εισόδου πολλαπλασιασμένη με το κέρδος ανοικτού βρόχου (Α). Η τάση εξόδου Vo είναι θετική όταν η τάση που εφαρμόζεται στον θετικό ακροδέκτη (μη αναστρέφουσα είσοδος – V+) είναι μεγαλύτερη εκείνης που εφαρμόζεται στον αρνητικό ακροδέκτη (αναστρέφουσα είσοδος – V-). Ένας ιδανικός τελεστικός ενισχυτής έχει ένα άπειρο κέρδος ανοικτού βρόχου, με αποτέλεσμα να απαιτείται η διαφορά δυναμικού μεταξύ των εισόδων V+ και V- να είναι ακραία μικρή ώστε η τάση εξόδου Vo να είναι πεπερασμένη. Επιπλέον, ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής έχει άπειρη αντίσταση εισόδου και μηδενική αντίσταση εξόδου. Έτσι, στην ανάλυση κυκλωμάτων με τελεστικούς ενισχυτές θεωρούμε ότι το ρεύμα στους ακροδέκτες εισόδου είναι μηδενικό, ενώ η τάση εξόδου, όταν ο τελεστικός οδηγεί κάποιο φορτίο, είναι ίση με την τάση του



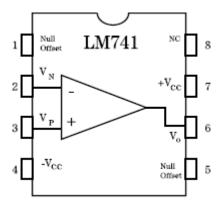
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργαστήριο Συστημάτων VLSI και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών



ανοικτού κυκλώματος. Η τάση εξόδου ενός τελεστικού ενισχυτή δίδεται από την ακόλουθη σχέση:

$$V_0 = A(V_+ - V_-)$$

Οι τελεστικοί ενισχυτές χαίρουν ευρύτατης χρήσης σε πολλές εφαρμογές. Μπορούν να διασυνδεθούν με κατάλληλους τρόπους ώστε να επιτελέσουν διάφορες λειτουργίες όπως: αναστροφή, ενίσχυση, υποβιβασμό, άθροιση, ολοκλήρωση, διαφόριση, φιλτράρισμα καθώς και τη γένεση σημάτων (ταλαντωτές). Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση θα εξετασθούν η αναστρέφουσα και η μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία ενισχυτή τάσης καθώς και η συνδεσμολογία του ακόλουθου τάσης.



Σχήμα 1.2: Η τοπολογία των ακροδεκτών του τελεστικού ενισχυτή στο chip 741

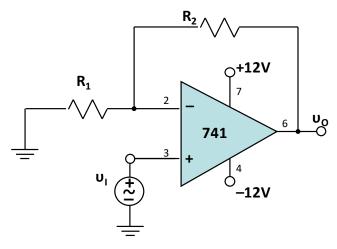
1.1.2 Το ολοκληρωμένο κύκλωμα 741: Στο Σχήμα 1.2 δίδεται η τοπολογία των ακροδεκτών του ολοκληρωμένου τελεστικού ενισχυτή 741. Οι ακροδέκτες του είναι σε διάταξη DIP (dual in-line package) όπου ο ακροδέκτης υπ' αριθμόν 1 προσδιορίζεται με βάση την εγκοπή η οποία υπάρχει στην μία πλευρά του ολοκληρωμένου. Προς τη μεριά αυτής της εγκοπής βρίσκονται, αριστερά ο πρώτος ακροδέκτης και δεξιά ο τελευταίος. Ο ακροδέκτης νούμερο 2 είναι η αναστρέφουσα είσοδος V-, ο νούμερο 3 είναι η μη αναστρέφουσα είσοδος V+, ενώ ο ακροδέκτης 6 είναι η έξοδος Vo. Συνήθως οι ακροδέκτες τροφοδοσίας -VCC και +VCC, 4 και 7 αντίστοιχα, δεν περιγράφονται στο κυκλωματικό σύμβολο του ενισχυτή για λόγους μεγαλύτερης ευκρίνειας του σχηματικού, αλλά στην πράξη θα πρέπει πάντα να συνδέονται στις κατάλληλες τάσεις τροφοδοσίας ώστε το κύκλωμα να λειτουργήσει. Οι ακροδέκτες 1 και 5 χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό της τάσης εκτροπής (offset voltage) του τελεστικού δηλ. της τάσης που εμφανίζει στην έξοδό του όταν και οι δύο είσοδοι είναι γειωμένες. Σε πολλές εφαρμογές οι ακροδέκτες αυτοί δεν χρησιμοποιούνται και αφήνονται ανοικτοκυκλωμένοι («στον αέρα»). Ο ακροδέκτης 8 δεν παρέχει καμία λειτουργία και δεν χρησιμοποιείται. Πρόσθετα χαρακτηριστικά του κυκλώματος θα βρείτε στα εγχειρίδια χρήσης κυκλωματικών στοιχείων στο τέλος του φυλλαδίου.



Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργαστήριο Συστημάτων VLSI και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών



1.2.2 Μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία: Σχεδιάστε την μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία του Σχήματος 1.5 στο περιβάλλον σχεδίασης του OrCAD. Επιλέξτε την R2=10ΚΩ. Χρησιμοποιήστε σαν πηγή σήματος εισόδου $υ_l$ την ημιτονική πηγή VSIN. Η τροφοδοσία του τελεστικού να πραγματοποιηθεί και πάλι με βάση το Σχήμα 1.4 και με τη χρήση DC πηγών τροφοδοσίας (VDC).



Σχήμα 1.5: Η μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία

Α) Δώστε την έκφραση του κέρδους κλειστού βρόχου A_{ν} της συνδεσμολογίας και υπολογίστε την R1 έτσι ώστε να πάρετε κέρδος α) 21 και β) 201.

Υπογραφή:

$A_{\upsilon} = UO/UI = 1 + R2/R1$	(τύπος)			
A _U = 21	$A_{\rm U} = 201$			
$R1_a = 500\Omega$	$R1_b = 50\Omega$			

B) Χρησιμοποιήστε για είσοδο στο κύκλωμα μία σταθερή τάση 50mV (στις παραμέτρους της πηγής σήματος VSIN δώστε FREQ=1KHz, VAMPL=0 και VOFF=50mV). Αντικαταστήστε στο κύκλωμα σας τις τιμές της R1 που βρήκατε νωρίτερα και εκτελέστε "ανάλυση στο πεδίο του χρόνου – transient analysis" (χρόνος εκτέλεσης 2ms – βήμα 1μs). Κάντε χρήση της βιβλιοθήκης "opamp.lib". Καταγράψτε τις τιμές της εξόδου V_O σε κάθε περίπτωση.

Υπογραφή:

$V_1 = 50 \text{mV} (v_i = 0)$	
$R1_a = 500\Omega$	$R1_b = 50\Omega$
V ₀ = 1,05V	V ₀ = 10,5V

Γ) Χρησιμοποιήστε για είσοδο στο κύκλωμα ημιτονοειδές σήμα συχνότητας 1KHz και πλάτους 50mV (στις παραμέτρους της πηγής σήματος VSIN δώστε την τιμή FREQ=1KHz, VAMPL=50mV και VOFF=0). Με τις ίδιες τιμές για την R1 εκτελέστε "ανάλυση στο πεδίο του χρόνου – transient analysis" (χρόνος εκτέλεσης 2ms – βήμα 1μs). Καταγράψτε τις τιμές της υ_0 (υ_{01} και υ_{02}) για τις τιμές της υ_i στις δύο κορυφές του ημιτόνου εισόδου (υ_{i1} και υ_{i2}), για κάθε τιμή της R1, καθώς και τη φάση της υ_0 σε σχέση με τη υ_i .



Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργαστήριο Συστημάτων VLSI και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών



Υπογραφή:

$V_i = 50$ mV και $V_i = 0$ [$v_i = v_i = V_i \times sin(\omega t)$]	
R1 _a =	R1 _b =
υ_{i1} = 50mV $\Rightarrow \upsilon_{o1}$ =	υ_{i1} = 50mV $\Rightarrow \upsilon_{o1}$ =
υ_{i2} = -50mV \Rightarrow υ_{o2} =	υ_{i2} = -50mV $\Rightarrow \upsilon_{o2}$ =
Φάση υ₀ ως προς υί:	Φάση υ _ο ως προς υ _i :

Δ) Χρησιμοποιήστε για είσοδο στο κύκλωμα ημιτονοειδές σήμα συχνότητας 1KHz και πλάτους 50mV με DC συνιστώσα ίση με 50mV (στις παραμέτρους της πηγής σήματος VSIN δώστε την τιμή FREQ=1KHz, VAMPL=50mV και VOFF=50mV). Με τις προηγούμενες τιμές για την R1 εκτελέστε "ανάλυση στο πεδίο του χρόνου – transient analysis" (χρόνος εκτέλεσης 2ms – βήμα 1μs). Καταγράψτε τις τιμές της υ_0 για τις τιμές της υ_1 στις δύο κορυφές του ημιτόνου εισόδου και για κάθε τιμή της R1 καθώς και τη φάση της υ_0 σε σχέση με τη υ_1 . Ποια η DC τιμή υ_0 του σήματος εξόδου; Είναι αναμενόμενη αυτή η τιμή και γιατί;

Υπογραφή:

V_i = 50mV και V_l = 50mV [v_l = v_l + v_i = v_l + v_i ×sin(w t)]					
R1 _a =	R1 _b =				
$U_{11} = 100 \text{mV}$ \Rightarrow $U_{01} =$	$\upsilon_{11} = 100 \text{mV}$ $\Rightarrow \upsilon_{01} =$				
$\upsilon_{12} = 0 \text{mV}$ $\Rightarrow \upsilon_{02} =$	$\upsilon_{12} = 0 \text{mV}$ $\Rightarrow \upsilon_{02} =$				
Φάση υο ως προς υι:	Φάση υ _ο ως προς υ _ι :				
V ₀ =	V ₀ =				

Ε) Για τη μεγαλύτερη τιμή της R1, εκτελέστε DC ανάλυση σαρώνοντας την είσοδο V_I από -12V έως +12V με βήμα 10mV (στις παραμέτρους της πηγής σήματος VSIN δώστε την τιμή DC=0). Στο γραφικό περιβάλλον του PSPICE παρουσιάστε τη χαρακτηριστική μεταφοράς του κυκλώματος $V_O = f(V_I)$. Σχεδιάστε τη χαρακτηριστική μεταφοράς στο πλαίσιο των αξόνων που ακολουθεί (βαθμονόμηση αξόνων!) και προσδιορίστε την γραμμική της περιοχή. Ποια είναι η μέγιστη και η ελάχιστη τάση V_O που μπορεί να δώσει το συγκεκριμένο κύκλωμα; Συγκρίνεται αυτές τις τιμές με τις αντίστοιχες τιμές των τάσεων τροφοδοσίας του τελεστικού. Υπάρχει διαφορά και αν ναι γιατί; Από τη γραφική παράσταση προσδιορίστε το κέρδος του κυκλώματος.



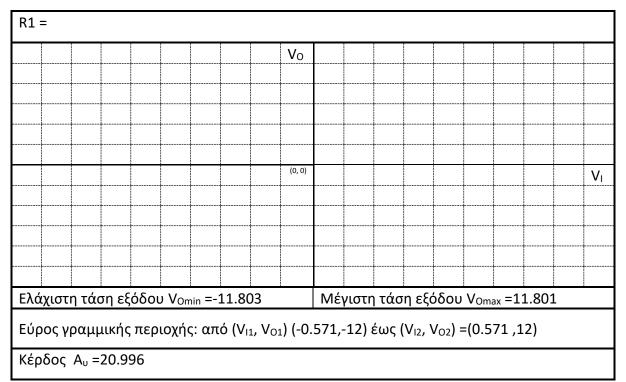
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής



Εργαστήριο Συστημάτων VLSI και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Υπογραφή:

V _{I(V)}	-2,5	-2	-1.5	-1	-571m	- 500m	- 300m	- 100m	100m	300m	500m	571m	 2,5
V _{O(V)}	- 11.991	- 11.991	- 11.991	- 11.991	- 11.991	-10.5	-6.3	-2.1	2.1	6.3	10.5	11.991	 11.991



Υπογραφή:

ΣΤ) Για τη μεγαλύτερη τιμή της R1, εκτελέστε AC ανάλυση σαρώνοντας τη συχνότητα της εισόδου από τα 10Hz έως τα 100MEGHz με βήμα 10 σημεία/δεκάδα (στις παραμέτρους της πηγής σήματος VSIN δώστε την τιμή AC=1V). Στο γραφικό περιβάλλον του PSPICE παρουσιάστε τα διαγράμματα Bode για το κέρδος του κυκλώματος (σε dB) και την φάση ως προς τη συχνότητα. Προσδιορίστε το εύρος ζώνης του κυκλώματος. Ποια η συχνότητα γονάτου -3dB ($f_{\text{(-3dB)}}$); Ποιο το κέρδος $A_{\text{υ}}$ μέσα στο εύρος ζώνης; Το αποτέλεσμα της ανάλυσης για το κέρδος συμπίπτει με το αντίστοιχο της περίπτωσης (E); Ποια η συχνότητα μοναδιαίου κέρδους ($f_{\text{(0dB)}}$); Ποια η κλίση της χαρακτηριστικής του κέρδους στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων; Ποια η φάση στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων;

Υπογραφή:

R1 = 500Ω	
Συχνότητα γονάτου f _(-3dB) = 48.774KHz	Εύρος ζώνης =10Ηz εως 48.774
Κέρδος Α _{υ(dB)} = 26442dB	εντός του εύρους ζώνης
Συχνότητα μοναδιαίου κέρδους f _(OdB) = 8	896.546KHz
Κλίση χαρακτηριστικής = 20.385	dB/dec



Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργαστήριο Συστημάτων VLSI και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών



Φάση (χαμηλές συχνότητες) = -24.176mdegrees εως -1,2221degrees

ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α),Β),Ε),ΣΤ)

A)	1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(a)	Au = Uo = 1+ R2 => 21 = 1 + 104 => (R1 = 5000)
3)	10 = U0 = 1+ R2 => 201 = 1 + 104 - 1 R1 = 500/
B)	Tra oradepri town Volt Somv Exoups
1	Tra ora Jepn town Volt 50mV Exorpre rua $B_1a = 500 = 500$ Swa $V_0 = (1 + R_2/R_1) = (1+20)50\cdot10^{\frac{3}{2}} = 1.05V$ rua $B_1b = 502$, Swa $V_0 = (1 + R_2/R_1) Ui = (1+200)50\cdot10^{-3} = 10.05V$
6)	
8)	
	Pria=5002 DC Avadion Sapusa ano -QV por Eus +12V
	Πενιση ταση ε τοδου = 11.80 1
	παραπρώμε δει θα αναμέναμε η τάση νο να φτάσει σε επίπεδο προσοβοίωσης τα Vmax = 12 V π Vmm = 12 V σο
	Sondadon kan on myes carns car redestion evioxum comang
	raidi o evickuths pas seu evas sauros urrappor oncideres
	Kai anokanoseis onore avaluate rapintotion ripin. Expos spatificials repropries (V-, V-) Ews (V+, V+) = 0,574-12) Ews (6.57412)
	Fig to Ay da maper the Kinson to Endras of or duo texaua
	Apa, Av- 40-46 - 83925 - 20.336 Tool coma and the Xe-XA 398.581.10-3 cum the available
	O REDMINOTE 95



Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργαστήριο Συστημάτων VLSI και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

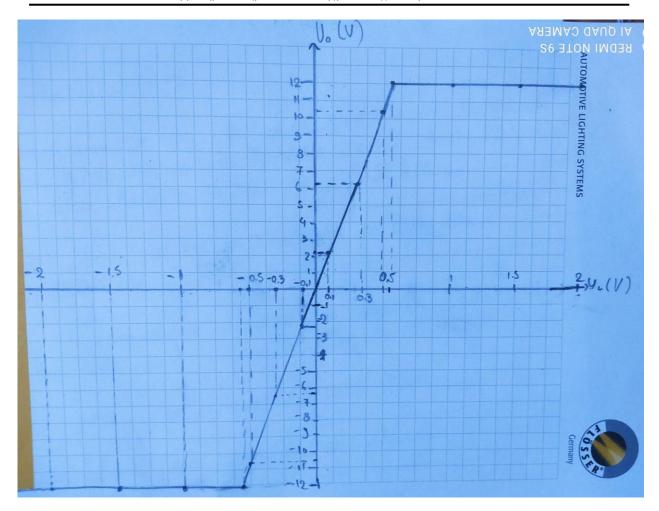


대 모드 로마 42 도파 6조 전 3포 10호
VI(V) -2,5 -2 -1 1-0.541 -500m 300m -100 100m 300m 5004 0
11.991 11.991 11.99 11.991 10.5 63 2.1 21 63 10.5
U= (1+Re)U1 = (1+20) U1 = 21.U1
TEVILOS EUTROS: Un= 21 UI pa tru xpatifilión reproxima - OSTIC UI 20.571 (Volt)
12 Vo= 21 (0.571) =-11.991 Volt a pepoin au s
Manos you make stand -2.540.571 Self evider on youldlike
23 Uo = 21(0.571) = -11.991 Volt +11111-
33 Uo = 21 (-0.571)=-11.991 Welt
49 Uo = -11-991 Volt
Sil Vo= 21 (0.500) = -10.5 Volt
69 Vo = 21 (-0.300) = -6.3 Volt
72 Vo = 21(0.100) = -2.1 Volt
81 Vo = 21 (0.100) = 2.1 Volt
92) Vo= 21 (0.300) = 6.3 Volt
02 Vo = 21 (0.500) = 10.5 Volt
112) Vo = 21 (0.571) = 11.991 V.dt
· ·
121) Vo = 21 (0.571) = 11.991 WH REDMI NOTE 98
ALQUAD CAMERA = 11.931 Wit



Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργαστήριο Συστημάτων VLSI και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών







Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργαστήριο Συστημάτων VLSI και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών



α του συκυστατα χουασων βλετων ότε η μαχ τιμη των κερόων είναι 26.442 db Αρα θα ποιω σια 23.442 db οία 48.774 lbe δία 48.774 lbe δία 48.774 lbe δία μεταιομε μεχαλι μεταθολία στην ευιόχυση. Αρα, βαιο (1042 48.774 lbe) δ) κερόω Αυ = 26.442 db δ) κερόω Αυ = 26.442 db δ) κερόω Αυ = 26.442 db δ) μεταιτικών οι Αν των δυο ερωτομίστων συρω απο την κλίων την ευθώς βρηκαμι στο (ε) Ανών-20.331 και σε αυτο Αυ(21)-26.442 hpa, βε) f (σ) ε) f (σ)β δηλ 20log(1)-0 βε που το βρισφιμε γιο βολ.246 κθε α) κλίως χαρακτηριστικό διαλεχω διο σκνότητε πκ. βι-100 lbe ται 12-1 Uβ ωνιε f2 10 πρα, β(1002, 19.248) Ε) Διαφορα φάσης στις χαριτικός φάσεις (10β2. 18.12)	IAC - Avaduonil
Sibri Seu Presoule μεχανη μεταθούν στην ενισκύση. Αρα, Λεω (10112 48. 47 4 κΗΣ) δ) Κερδος Αυ = 26.442 dB δ) Δεω συμπιτισουν οι Αν των δυο ερωτημοτων αφου απο την τινόση της ευθωάς Βρηκαμι στο (ε) Αυων- 20.331 ται σε αυτο Αυ(21)- 26.442 Αρα, Αε) + Α (π) ε) \$\int (018) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Espans Eval 26.4412db Apa Da Trans and 23.442dB
8) Δευ σήπητων οι Αν των δυο ερωτημοτων αφω απο την ελίση της ενθείας Βρημαμι στο (ε) Ανα)- 20.931 και σε αυτο Αυ(2τ)- 26.442 . Αρα, Α(ε) + Α(σ) ε) f (odb) επλ. 20log(1) = 0 Hz πον το βρισφυρε f(ode)- 826.546 κΗτ α) Κλίδη χαραντηρισμού διαλεχεύ διο συνότητε πχ. 1,-100 κΗτ και 12 = 1 U Hz ωνιε 12 = 10 Αρα, Α(100χ, 19.248) Ε) Διαφορα φάσης στις χαρισκές φάσεις (101/2 . 1ΚΗτ)	выть бы васпоине нехат регаводи от выблиот. Ара,
aπο την ελίση της ευθείας βρηταμε στο (ε) Αυε)- 20.331 και σε αυτο Αυ(2τ)- 26.442 . Αρα, Ακε) + Α (σ) ε) f (οΔΒ) επλ. 20log(1) = O Hz τον το βρισσυμε f(οΔΒ)= 8%.546 κΗz α) Κλίδη χαρακτηριστική διαλεχευ διο σκνότητε της 1;-100 κΗz και fz=1 LHz ωνίε fz=10 Αρα, Α(100χ, 13.248) Ε) Διαφορα φάσης στις χαμπλές φάσεις (10Hz . 1κHz)	8) Keedos Au= 26.442 dB
1) Kalon χαρακτηριστικής διαλέχευ διο συκνότητε πχ 1,-100 εμε και 12 = 1 μ 12 μπε 12 10 Αρα, Α(100 ε, 19.248) Β(1μ, 1.137) 'Αρα, (y 6 - y A) = 20.385 dB dec ε) Διαφορα φάσης στις χαριπλές φάσεις (101/2 164/2)	and The whon this everies Boneage 000 (6) Auco- 20.331
BCILL, -1.137) Apa, (yB-yA) = 20.385 dB/dec E) Diagoga gams ous xapinies gaseus (10Hz 1KHZ)	E) f (odB) Snd. 20log(1) = OHZ TON TO BOWDER
E) Diagopa gaons ous xapentes gaoses (10Hz 1KHz)	a) Know Xapa kenpiolikus Eradexu dio auxioente π_{K} di-100 kHz kai $f_{2}=1$ UHz unie $f_{2}=10$ Apa, A(100x, 1-9.248)
E) Diagona gaions ous xapiniès gaioses (10Hz 1KHZ)	BCIM, -1.137) 'Apa, (yB-yA) = 20.385 dBldec
-1,221 deagres trodu prepri Tepititas was pe to probe 8	were oxeder oradepri n ottola Eval -24.176m dagges Euts